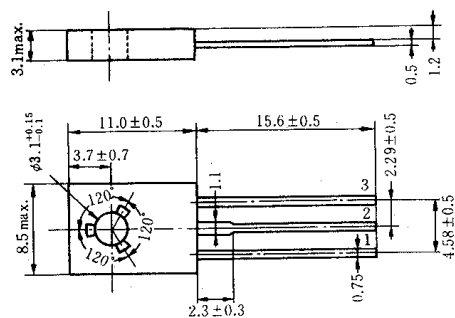


シリコン N チャンネル MOS FET

高速度電力スイッチング用
高周波電力増幅用

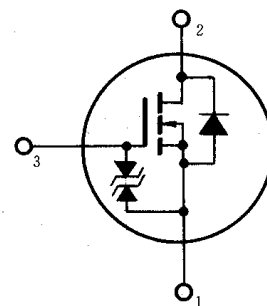
SILICON N-CHANNEL MOS FET

HIGH SPEED POWER SWITCHING
HIGH FREQUENCY POWER AMPLIFIER



(JEDEC TO-126 MOD.)

1. ソース: Source
 2. ドレイン: Drain
 3. ゲート: Gate
- (Dimensions in mm)



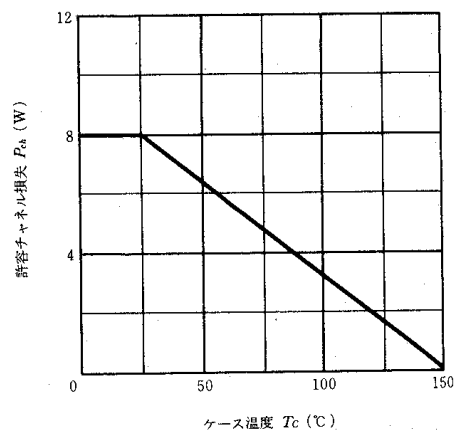
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SK511	Unit
ドレイン・ソース電圧		V_{DSS}	250	V
ゲート・ソース電圧		V_{GSS}	± 9	V
ドレイン電流		I_D	0.3	A
せん頭ドレイン電流		$I_{D(\text{peak})}$	0.5	A
逆ドレイン電流		I_{DR}	0.3	A
許容チャネル損失		P_{ch}^*	8	W
チャネル温度		T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

* $T_c = 25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c = 25^\circ\text{C}$

許容チャネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧		$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 1\text{mA}, V_{GS} = 0$	250	—	—	V
ゲート遮断電流		I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 9\text{V}, V_{DS} = 0$	—	—	± 1	mA
ドレイン電流		I_{DSS}	$V_{DS} = 200\text{V}, V_{GS} = 0$	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧		$V_{GS(off)}$	$I_D = 1\text{mA}, V_{DS} = 20\text{V}$	1.0	—	5.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗		$R_{DS(on)}$	$I_D = 0.1\text{A}, V_{GS} = 9\text{V}^*$	—	30	50	Ω
ドレイン・ソース飽和電圧		$V_{DS(on)}$	$I_D = 0.1\text{A}, V_{GS} = 9\text{V}^*$	—	3.0	5.0	V
順伝達アドミタンス		$ y_{fs} $	$I_D = 0.15\text{A}, V_{DS} = 20\text{V}^*$	50	80	—	mS
入力容量		C_{iss}	$V_{DS} = 10\text{V}, V_{GS} = 0$ $f = 1\text{MHz}$	—	20	—	pF
出力容量		C_{oss}		—	10	—	pF
逆伝達容量		C_{rss}		—	2.5	—	pF

* パルス測定

* Pulse Test